

Information



D 816 A, D 816 B, D 816 W,
D 816 G, D 816 D

1/86

Herstellerland : UdSSR

Übersetzung, bearb.

Allgemeines

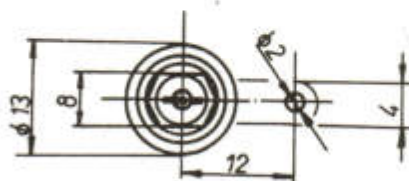
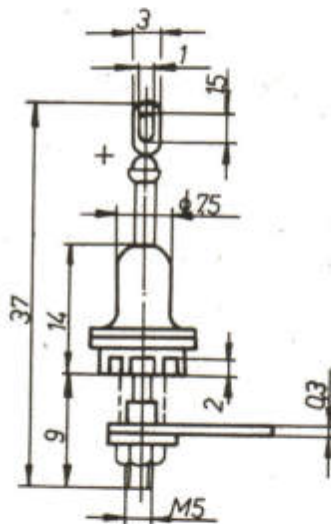
Die Silizium-Z-Dioden D 816 A - D 816 D sind für den Einsatz in Spannungs- und Stromstabilisatoren, in Impulsbegrenzungsschaltungen und als Bezugsspannungsquellen vorgesehen.

Sie sind in einem Metall-Glas-Gehäuse untergebracht.

Die Masse einer Z-Diode beträgt maximal 6 g.

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur $t_{amb} = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$



Grenzwerte

Kennwerte	Kurz- zeichen	W e r t					Meßbedingungen
		D 816 A	D 816 B	D 816 W	D 816 G	D 816 D	
Maximaler Z-Strom	I_{Zmax}	230	180	150	130	110	mA $t_{case} = -60$... $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{case} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Minimaler Z-Strom	I_{Zmin}	90	75	60	55	45	mA $t_{case} = -60$... $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Gesamtver- lustleistung	P_{tot}	5	5	5	5	5	W $t_{case} = -60$... $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ $t_{case} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
		2	2	2	2	2	

Elektrische Kennwerte

Kennwerte	Kurz- zeichen	W e r t					Meßbedingungen
		D 816 A	D 816 B	D 816 W	D 816 G	D 816 D	
Z-Spannung	U_Z	22	27	33	39	47	V $I_Z = 150\text{ mA}$
Differentieller Widerstand	r	10	12	15	18	22	Ω $I_Z = 150\text{ mA}$
Z-Spannungs- toleranz	ΔU_Z	± 15	± 15	± 15	± 15	± 15	% $I_Z = 150\text{ mA}$
Temperatur- koeffizient der Z-Spannung	TKU_Z	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	%/K

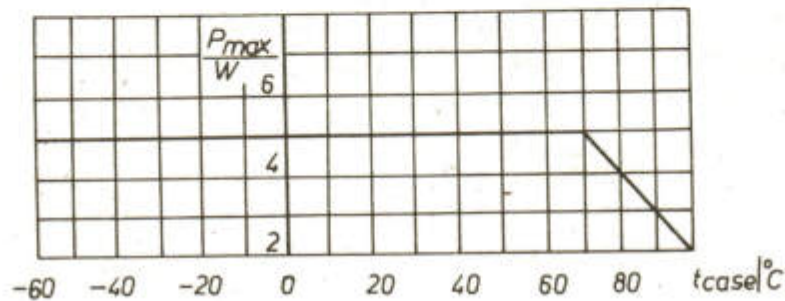


Bild 2: Abhängigkeit der Grenzverlustleistung der Z-Dioden von der Gehäusetemperatur t_{case}

Anwendungs- und Betriebshinweise

Beim Betrieb muß in allen Betriebsarten unbedingt eine Gehäusetemperatur von maximal $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ gewährleistet sein. Bei der Montage der Z-Dioden dürfen am oberen Anschluß Kräfte von maximal $0,1\text{ kp}$ angreifen.

Bei der Befestigung der Z-Diode an der Wärmeableitung muß die Zugkraft im Bereich von $7 - 10\text{ kp}$ liegen.

Bei der Befestigung der Anschlußleitungen am oberen Anschluß durch Löten muß die Löttemperatur im Bereich von $250 \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ liegen und die Löttdauer darf 3 s nicht überschreiten.

Die vorliegenden Datenblätter dienen
ausschließlich der Information!
Es können daraus keine Liefermög-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet werden.
Änderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber:

vob applikationszentrum elektronik berlin
im vob kombinat mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055